

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР КТ3102А/Е

Предельные параметры ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Параметр	Обозначение	КТ3102А/Е	Ед. изм.
Напряжение коллектор-база	V_{CBO}	50/20	В
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CEO}	50/20	В
Напряжение эмиттер-база	V_{EBO}	5/5	В
Ток коллектора	I_C	100/100	мА
Ток базы	I_B	50/50	мА
Максимальная мощность рассеяния	P_C	250/250	мВт
Температура перехода	T_J	125	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	-55 до +125	$^\circ\text{C}$

Электрические характеристики

Параметр	Обозна-	Условия	КТ3102А/Е	Ед.

	чение	измерения	Мин.	Тип.	Макс.	изм.
Макс. доп. напряжение коллектор-база	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=50/15 \text{ мкА}, I_E=0$	50/20	-	-	В
Макс. доп. напряжение коллектор-эмиттер	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1 \text{ мА}, I_B=0$	50/20	-	-	В
Макс. доп. напряжение эмиттер-база	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10 \text{ мкА}, I_C=0$	5/5	-	-	В
Обратный ток коллектора	I_{CBO}	$V_{CB}=50/20 \text{ В}, I_E=0$	-	-	50/15	нА
Обратный ток эмиттера	I_{EBO}	$V_{EB}=5 \text{ В}, I_C=0$	-	-	50/15	нА
Статический коэфф. передачи по току	h_{FE}	$V_{CE}=5 \text{ В}, I_C=2 \text{ мА}$	100/400	-	200/1000	-
Напряжение база-эмиттер	V_{BE}	$V_{CE}=5 \text{ В}, I_C=2 \text{ мА}$	-	-	0.7/0.7	В
Напряжение насыщ. коллектор-эмиттер	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100 \text{ мА}, I_B=5 \text{ мА}$	-	-	0.3/0.3	В
Напряжение насыщения база-эмиттер	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100 \text{ мА}, I_B=5 \text{ мА}$	-	-	1.0/1.0	В
Предельная частота коэффициента передачи тока	f_T	$V_{CE}=5 \text{ В}, I_C=1 \text{ мА}$	250/250	300/300	-	МГц
Шумовой фактор	NF	$V_{CE}=5 \text{ В}, I_C=0.2 \text{ мА}$ $R_G=2 \text{ кОм}, f=1.0 \text{ кГц}$	-	-	10/4	дБ
Выходная емкость	C_{ob}	$V_{CB}=5 \text{ В}, I_E=0$ $f=1 \text{ МГц}$	-	-	6/6	пФ